

FERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL ELEMENT

Patent Number: JP62205319
Publication date: 1987-09-09
Inventor(s): TSUBOYAMA AKIRA; others: 01
Applicant(s): CANON INC
Requested Patent: ☐ JP62205319
Application Number: JP19860047340 19860306
Priority Number(s):
IPC Classification: G02F1/133; G09F9/30
EC Classification:
Equivalents: JP1940426C, JP6068589B

Abstract

PURPOSE:To remove defect of orientation due to difference of stages of an auxiliary electrode and to obtain uniform monodomain on an interface with a substrate by covering the auxiliary electrode formed with metallic film contacting with a stripe electrode with spacers.

CONSTITUTION:A glass substrate 2 is constituted of a group of strip-shaped signal electrode 4 and an auxiliary electrode 5 formed of Al film at one end thereof, and polyimide coating film 6 is formed uniformly on the surface of the substrate. Spacers 7 for keeping the cell thickness are formed on the substrate 2 so as to cover the auxiliary electrode. On one hand, a group of stripe scanning electrode 3, auxiliary electrode 5, and polyimide film 6 are formed similarly on the glass substrate 1. The substrate 1 and the substrate 2 are arranged in such manner that upper and lower electrode groups intersect each other, and ferroelectric liquid crystals 8 are filled in the inside thereof. Further, the thickness of the coating film 6 of the substrate 1 is made rather thicker to mitigate the stage difference in the parallel direction to some degree and the direction of orientation treatment is arranged to parallel direction to the direction of the strip electrode. Thus sufficiently good monodomain contg. no defect in the interface is obtd.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 昭62-205319

⑬ Int.Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和62年(1987)9月9日

G 02 F 1/133

3 2 3

8205-2H

G 09 F 9/30

3 2 0

8205-2H

6731-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 強誘電性液晶素子

⑯ 特 願 昭61-47340

⑰ 出 願 昭61(1986)3月6日

⑱ 発 明 者 坪 山 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
 ⑲ 発 明 者 谷 口 修 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
 ⑳ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
 ㉑ 代 理 人 弁理士 豊田 善雄

明 細 書

1. 発明の名称

強誘電性液晶素子

2. 特許請求の範囲

1) 一对の基板間に強誘電性液晶を挟持し、互いに交差する走査電極と信号電極を設けたマトリクス構造の液晶素子であって、前記走査電極と信号電極のうち少なくとも一方が該電極の長手方向に沿って接した金属フィルムで形成した補助電極を有し、該補助電極がセル厚を保持するためのストライプ状のスペーサーに被覆されていることを特徴とする強誘電性液晶素子。

2) 前記強誘電性液晶がスメクティック相であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の強誘電性液晶素子。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は液晶表示素子や液晶—光シャッター等に用いられる液晶素子に関し、詳しくは強誘電性

液晶を用いた液晶素子に関するものである。

〔開示の概要〕

本明細書及び図面は、強誘電性液晶を用いた液晶素子において、ストライプ状の電極に沿って接した金属フィルムで形成した補助電極をスペーサーで被覆することにより、補助電極の段差による配向欠陥をなくすることができるようにしたものである。

〔従来の技術〕

近年、強誘電性液晶素子は、その高速応答性とメモリー性から高精細大型ディスプレイへの応用が考えられている。このような液晶素子の構成としては、交差した走査電極群と信号電極群の交差部を画素とする単純マトリクス構造が一般に用いられている。この構造は高精細になると電極の幅が狭くなり、電極の1ラインあたりの抵抗値が高くなるため、1ライン中で電圧値にばらつきが生じ、駆動に必要な電圧が各画素に十分に印加されないことがあった。そこでこの欠点を解決するため、透明電極に金属補助配線を設けることが行な

われている。この配線を設けることにより抵抗値は下がり、電圧のばらつきは少なくなる。

〔発明が解決しようとする問題点〕

現在、強誘電性液晶で最も実用性が高いものは、カイラルスメクティック相を持つものである。しかしながら、この液晶相は基板との界面に段差があると配向欠陥を生じ、均一なモノドメインが得られなかった。したがって、前述したように金属補助線を設けると基板上に段差を生じ、均一なモノドメインとならず適正な駆動特性が得られないという欠点があった。

本発明は、上記従来例の欠点を除去し、適正な駆動特性を得ることのできる強誘電性液晶素子を提供することを目的とするものである。

〔問題点を解決するための手段〕

上記問題点を解決するための手段を、実施例に対応する第1図を用いて説明すると、本発明は一对の基板1、2間に強誘電性液晶8を挟持し、互いに交差する走査電極群3と信号電極群4を設けたマトリクス構造の液晶素子であって、前記走査

電極群3と信号電極群4のうち少なくとも一方が、該電極の長手方向に沿って接した金属膜で形成した補助電極5を有し、一方の補助電極がセル厚(平行基板間の間隔)を保持するためのストライプ状のスペーサー7に被覆されていることを特徴とする強誘電性液晶素子である。

〔作用〕

ストライプ状の駆動電極に沿って設けられた補助電極は、同じ方向に形成されるストライプ状のスペーサーによって覆われるため、補助電極による段差は除去される。この場合、基板表面の配向処理はストライプの方向と直交する方向に施されるが、前述したように基板上の段差が除去されているため、界面での配向欠陥を防止することができる。一方、対向する側の基板においては、駆動電極と補助電極のストライプの方向と同じ方向に配向処理が施される。すなわち、液晶分子の配向方向と直交する方向においては段差を有するが、平行方向の段差はない。この平行方向における段差の場合、液晶分子の配向欠陥を生じる割合が非

3

常に少ないため、配向方向と直交する基板上の補助電極だけをスペーサーで覆うことにより、上下基板の界面から良好なモノドメイン構造を形成させることができる。

〔実施例〕

本発明の一実施例を第1図及び第2図と共に説明する。第1図は第2図のX-X'断面に相当する素子の部分断面図、第2図は素子の平面図である。図において、ガラス基板2はストライプ状の信号電極群4と、この信号電極群4の一端にAl₂(アルミニウム)膜で形成した補助電極5を有し、基板表面には一様にポリイミド被膜6が形成されている。このガラス基板2には、さらにセル厚を保持するためのスペーサー7が補助電極5を覆うように形成されている。一方、ガラス基板1も同様にしてストライプ状の走査電極群3、補助電極5(図示せず)、ポリイミド被膜6が形成されている。この2枚の基板は、上下の電極群が互いに交差するよう配置され、内部には強誘電性液晶8が充填されている。

5

4

次に、この素子の具体的な作成例について述べる。

まず、ガラス基板2の全面にEB蒸着によりITO(Indium-Tin-Oxide)層1000Åを形成し、100μmピッチで90μm幅のストライプ電極をフォトレジストによりパターニングして信号電極群4とした。次に補助電極5を形成するため、全面にAlを蒸着後、フォトレジストにより信号電極端上に層厚1000Å、幅5μmでパターニングを行った。次に、これらの電極上にポリイミド被膜800Åをスピナーにより塗布した。このポリイミド被膜6には、日立化成社製PIQ(商品名)を用い、250℃で1時間焼成した。

次に補助電極5上にストライプ状スペーサーを形成するため、前記ポリイミド被膜6上に1.5μmでポリイミドを全面に塗布し、フォトレジストによりパターニングして幅15μm、層厚2μmのスペーサー7を形成した。このスペーサーにより補助電極5による段差は解消され、ガラス基板2の液晶の接する基板面に急激な段差は

6